

## TIA电力电子研究基地 6英寸SiC新生产线投产

国立研究开发法人 产业技术综合研究所  
住友电气工业株式会社

(日本时间 2016 年 11 月 4 日发布的新闻公告。)

自2015年11月起在TIA电力电子研究基地建设的新生产线顺利完工，可以批量生产开发碳化硅（SiC）功率半导体器件，并已投产。该基地成为世界上首个可以加工6英寸级大型晶片的开放式创新基地。

该生产线是由国立研究开发法人产业技术综合研究所（以下简称为“产综研”）与住友电气工业株式会社（以下简称为“住友电工”）携手合作建成的。该生产线在基础研究上更进一步，可以开发世界上最先进且最快的SiC功率半导体的批量生产技术、可靠性评价技术、品质评价技术，因此有望通过SiC功率半导体的实用化和正式普及来推动社会创新。

今后，产综研与住友电工将利用该生产线，开展最高水平的研究开发工作。此外，“TIA电力电子研究基地”作为最先进的生产线，将向电力电子产业进军，为日本产业界广泛利用提供平台。

### <新生产线的主要规格>

名称：TIA电力电子研究基地6英寸生产线

场所：产综研筑波西事业所 7 群（Super Clean Room研究楼）

面积：Clean Room面积 1500m<sup>2</sup>

附属设备等 1500m<sup>2</sup>

规格：6英寸碳化硅（SiC）功率半导体设备量产试制生产线